

Нагорнов Юрий Сергеевич

Список публикаций

- [1] Kostishko B.M., Guseva M.B., Khvostov V.V., Babaev V.G., Nagornov Yu.S., “Activation energy of the electron-beam-stimulated quenching of photoluminescence in porous silicon”, *Physics of low-dimensional structures*, **7** (1999), 9–14 [ISI Web of Knowledge](#).
- [2] Kostishko B.M., Atazhanov Sh.R., Puzov I.P., Salomatin S.Ya., Nagornov Yu.S., “Significance of heterojunctions in photoluminescence of carbonized porous silicon”, *Physics of low-dimensional structures*, **12** (1999), 1–6 [ISI Web of Knowledge](#).
- [3] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., Guseva M.B., Khvostov V.V., Babaev V.G., “Activation energy of the electron-beam-stimulated quenching of photoluminescence in porous silicon”, *Physics of Low-Dimensional Structures*, **1999**:7-8 (1999), 9–14.
- [4] Костишко Б.М., Атажанов Ш.Р., Пузов И.П., Саломатин С.Я., Нагорнов Ю.С., “Гетероструктурные эффекты в карбонизированном пористом кремнии”, *Письма в ЖТФ*, **26**:5 (2000), 42–48.
- [5] Костишко Б.М., Пузов И.П., Нагорнов Ю.С., “Стабилизация светоизлучающих свойств пористого кремния термовакuumным отжигом”, *Письма в ЖТФ*, **26**:1 (2000).
- [6] Kostishko B.M., Puzov I.P., Nagornov Yu.S., “Stabilization of luminous properties of porous silicon by vacuum annealing at high temperatures”, *Technical Physics Letters*, **26**:1 (2000), 26–28 [crossref](#) [ads*](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [7] Kostishko B.M., Atazhanov Sh.R., Shibaev P.V., Nagornov Yu.S., “Role of resonant charge-exchange in photoluminescence of B-doped carbonized porous silicon”, *Physics of low-dimensional structures*, **7** (2000), 47–52 [ISI Web of Knowledge](#).
- [8] Kostishko B.M., Atazhanov Sh.R., Puzov I.P., Solomatin S.Ya., Nagornov Yu.S., “Heterogeneous effect in carbonized porous silicon”, *Technical Physics Letters*, **26**:3 (2000), 199–201 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [9] Kostishko B.M., Puzov I.P., Nagornov Yu.S., “Stabilization of Light-Emitting Properties of Porous Silicon Thermal Vacuum Annealing”, *Technical Physics Letters*, **26**:1 (2000), 50–55.
- [10] Костишко Б.М., Нагорнов Ю.С., “Механизм водного дотравливания пористого кремния n-типа проводимости в электрическом поле”, *Журнал технической физики*, **71**:7 (2001), 60–66.
- [11] Костишко Б.М., Нагорнов Ю.С., “Механизмы гашения фотолуминесценции пористого кремния электронным облучением различной интенсивности”, *Письма в ЖТФ*, **27**:19 (2001), 58–65.
- [12] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., “Water after-etching of n-type porous silicon in an electric field”, *Technical Physics*, **46**:7 (2001), 847–852 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [13] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., “The mechanism of photoluminescence quenching in porous silicon by electron irradiation of various intensity”, *Technical Physics Letters*, **27**:10 (2001), 827–829 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [14] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., “Water after-etching of porous silicon in the presence of electric field”, *Physics of low-dimensional structures*, **9** (2001), 87–94 [ISI Web of Knowledge](#).
- [15] Костишко Б.М., Нагорнов Ю.С., Атажанов Ш.Р., Миков С.Н., “Особенности фотолуминесценции нанокристаллитов карбида кремния кубической модификации, легированного галлием”, *Письма в ЖТФ*, **28**:17 (2002), 74–81; Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., Atazhanov Sh.R., Mikov S.N., “The features of photoluminescence from nanograins of gallium-doped cubic silicon carbide”, *Technical Physics Letters*, **28**:9 (2002), 743–745 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [16] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., “The kinetics of destruction of molecular complexes adsorbed on a porous silicon surface by electron-beam irradiation at different densities”, *Vacuum*, **68**:3 (2002), 245–249 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).

- [17] Костишко Б.М., Нагорнов Ю.С., Саломатин С.Я., Атажанов Ш.Р., “Интерфейсный механизм фотолюминесценции карбонизированного пористого кремния”, *Письма в ЖТФ*, **30**:3 (2004), 7–13.
- [18] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., Appolonov S.V., “The modification of the properties of n-type conductivity porous silicon by argon ion irradiation”, *Vacuum*, **73**:1 (2004), 105–108 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [19] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., Salomatin S.Ya., Atazhanov Sh.R., “The interface mechanism of photoluminescence in carbonized porous silicon”, *Technical Physics Letters*, **30**:2 (2004), 88–90 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [20] Kostishko B.M., Nagornov Yu.S., Salomatin S.Ya., “The interface model of photoluminescence of carbonized porous silicon”, *Physics of low-dimensional structures*, **3** (2004), 51–57 [ISI Web of Knowledge](#).
- [21] Нагорнов Ю.С., Новиков С.Г., Павлов Д.Н., Русанова А.Е., *Аппаратные средства вычислительной техники*, методическое пособие. Извещение о государственной регистрации N 50200601, УлГУ, Ульяновск, 2006.
- [22] Нагорнов Ю.С., Костишко Б.М., Миков С.Н. и др., “Механизм образования нанокристаллов карбида кремния при высокотемпературной карбонизации пористого кремния”, *Журнал технической физики*, **77**:8 (2007), 135–139.
- [23] Нагорнов Ю.С., Смагин А.А., Шкиряк В.С., Долгов С.В., “Математическая модель синтаксического анализа исходного кода языка С при построении системы встроенного контроля памяти”, *Авиакосмическое приборостроение*, 2007, № 10, 14–18.
- [24] Nagornov Yu.S., Kostishko B.M., Mikov S.N. et al, “Formation of silicon carbide nanocrystals by high-temperature carbonization of porous silicon”, *Technical Physics*, **52**:8 (2007), 1093–1097 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [25] Нагорнов Ю.С., *Аппаратные средства вычислительной техники*, электронный учебный курс, УлГУ, Ульяновск, 2007.
- [26] Нагорнов Ю.С., Гноевых В.В., Портнова Ю.А., “Расчет упругих свойств и морфологии эритроцитов в рамках простой механической модели”, *В мире научных открытий*, 2008, 24.
- [27] Разумовская И.В., Булярский С.В., Светухин В.В., Шаронова Н.В., Золотовский И.О., Нагорнов Ю.С. и др., *Введение в нанотехнологии*, Учебно-методическое пособие по программе элективного курса по физике для учителей 10-11 классов средней общеобразовательной школы, УлГУ, Ульяновск, 2008, 147 с.
- [28] Костишко Б.М., Золотов А.В., Нагорнов Ю.С., “Моделирование деградации рельефа нанопористого кремния в процессе отжига в неоднородном температурном поле”, *Физика и техника полупроводников*, **43**:3 (2009).
- [29] Нагорнов Ю.С., Пчелинцева Е.С., Костишко Б.М. и др., “Моделирование радиационно-стимулированного источника тока на рпн-структурах”, *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки*, 2009, № 3, 113–125.
- [30] Kostishko B.M., Zolotov A.V., Nagornov Yu.S., “Simulation of degradation of the profile of nanoporous silicon in the course of annealing in an inhomogeneous temperature field”, *Semiconductors*, **43**:3 (2009), 355–358 [crossref](#) [ISI Web of Knowledge](#).
- [31] Нагорнов Ю.С., Махмуд-Ахунов Р.Ю., Костишко Б.М. и др., “О температурной зависимости межзатомного потенциала при молекулярно-динамическом моделировании свойств диоксида урана”, *Вопросы атомной науки и техники. Серия: Математическое моделирование физических процессов*, 2010, № 4, 27–34.
- [32] Нагорнов Ю.С., Махмуд-Ахунов Р.Ю. и др., “Построение температурно-зависимого потенциала межчастичного взаимодействия для диоксида урана”, *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки*, 2010, № 3, 156–164.
- [33] Стучебников В.М., Устинов А.А., Нагорнов Ю.С., “Исследование температурного дрейфа и нелинейностей тензопреобразователей давления на основе керамики”, *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки*, 2010, № 2, 62–69.
- [34] Нагорнов Ю.С., Мельников Б.Ф., Золотов А.В., “Подходу моделирования формирования нанокристаллов в процессе карбонизации пористого кремния”, *Вектор науки Тольяттинского государственного университета*, 2012, № 4, 89–93.
- [35] Нагорнов Ю.С., Кац А.В., “Квантово-механическое обоснование температурной зависимости потенциала в методе молекулярной динамики”, *Вектор науки ТГУ*, 2012, № 4, 94–98.
- [36] Нагорнов Ю.С., Кац А.В., “Определение температур фазовых переходов нанокристаллов диоксида урана методом молекулярной динамики”, *Вектор науки ТГУ*, 2012, № 4, 98–100.

- [37] Нагорнов Ю.С., Кац А.В., “Алгоритм расчета поверхностной диффузии методом молекулярной динамики”, *Вектор науки ТГУ*, 2012, №4, 101–103.
- [38] Боргардт А.А., Нагорнов Ю.С., “Многопоточный алгоритм монте-карло моделирования роста нанокристаллов”, *Вектор науки ТГУ*, 2012, №4, 32–36.
- [39] Нагорнов Ю.С., *Современные аспекты применения бетавольтаического эффекта*, монография, УлГУ, Ульяновск, 2012, 116 с.
- [40] Нагорнов Ю.С., *Самоорганизация нанокристаллов в карбонизированном пористом кремнии*, монография, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2012, 155 с.
- [41] Нагорнов Ю.С., *Методы моделирования атомарных и радиационно-стимулированных процессов в пористом кремнии*, монография, ТГУ, Тольятти, 2012, 175 с.
- [42] Нагорнов Ю.С., *Демонстрационные задачи по школьному курсу физики для учащихся 10-11 классов*, учебное пособие, ТГУ, Тольятти, 2012, 70 с.
- [43] Нагорнов Ю.С., *101 вопрос о нанотехнологиях*, учебное пособие, ТГУ, Тольятти, 2012, 110 с.
- [44] Nagornov Yu., Katz A., “Parametrically Temperature-Dependent Potential for Molecular Dynamics Simulation of Uranium Dioxide Properties”, *International Journal of Computational and Theoretical Chemistry*, **1**:3 (2013), 18–26.
- [45] Нагорнов Ю.С., *Моделирование упругих свойств клеток крови*, монография, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2013, 108 с.
- [46] Нагорнов Ю.С., Костишко Б.М., Пчелинцева Е.С., *Радиационно-стимулированные источники тока*, монография, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2013, 116 с.
- [47] Nagornov Yu.S., Katz A.V., “Calculation of phase transitions of uranium dioxide using structure factor in molecular dynamics”, *International Journal of Materials Science and Applications*, **2**:6 (2013), 228–232.
- [48] Нагорнов Ю.С., “Об одном алгоритме оптимизации расчетов методом Монте-Карло при моделировании роста кристаллов”, *Стохастическая оптимизация в информатике*, **9**:2 (2013), 96–107.
- [49] Нагорнов Ю.С., “Метод Монте-Карло, в котором вероятности переходов определяются межатомным потенциалом взаимодействия”, *Стохастическая оптимизация в информатике*, **9**:2 (2013), 88–95.
- [50] Нагорнов Ю.С., Жиляев И.В., “Оптимизация формы эритроцита в соответствии с данными атомно-силовой микроскопии”, *Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал*, **12**:1 (2013).
- [51] Нагорнов Ю.С., “Моделирование морфологии и жесткости мембраны эритроцитов после фемтосекундного лазерного облучения”, *Российский журнал биомеханики*, **17**:3(61) (2013), 112–121.